

2013 年 1 月 24 日

新型低通态电阻功率 MOSFET 产品的规格

型号编号	漏源极电压 (VDSS) [V]	栅源极电压 (VGSS) [V]	漏极电流 (ID) [A]	漏源极通态电阻 [mΩ]				输入电容 (Ciss) [pF]	封装
				VGSS = 10 V		VGSS = 4.5 V			
				典型	最大	典型	最大		
μPA2766T1A	30	±20	130	0.72	0.88	1.30	1.82	10850	8 引脚 HVSON
μPA2764T1A	30	±20	130	0.90	1.10	1.60	2.45	7930	
μPA2765T1A	30	±20	100	1.05	1.30	1.85	2.90	6550	